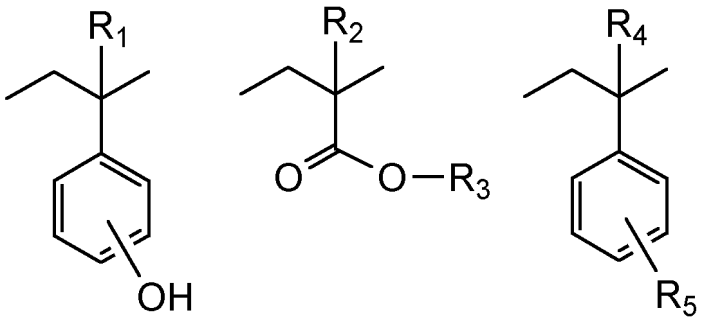
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2002-278070(P2002-278070A)
【公開日】平成14年9月27日(2002.9.27)
【出願番号】特願2001-80895(P2001-80895)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｆ　7/039　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/16　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　25/18　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/54　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/027　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｆ　7/039　６０１
Ｃ０８Ｋ　5/16
Ｃ０８Ｌ　25/18
Ｃ０８Ｋ　5/54
Ｈ０１Ｌ　21/30　５０２Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成17年11月29日(2005.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　（Ａ）活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物
（Ｂ）酸の作用により分解してアルカリ現像液中での溶解度が増大する樹脂
（Ｃ）有機塩基性化合物
（Ｄ）フッ素系及び／又はシリコン系界面活性剤
を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物において、
（Ｂ）の樹脂が下記一般式（Ｉ）、（II）で表される構造単位を有する樹脂（Ａ１）と、下記一般式（Ｉ）、（II）及び（III）で表される構造単位を有する樹脂（Ａ２）を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。
【化１】



(I) (II) (III)

一般式（Ｉ）～(III) 中、R_1 及びR_2 は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又はメチル基、R_3は置換されてもよい３級アルキル基を表す。

R_4は水素原子又はメチル基である。R_5は、水素原子、炭素数１～４の直鎖、分岐アルキル基、メトキシ基、又はアセトキシ基を表す。

【請求項２】　請求項１に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。